



半導体ニュースNo.519 とさしかえてください。

**最大定格 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$** 

			単位
最大電源電圧	$V_{CC\ max}$	$\pm 38$	V
動作時IC基板温度	$T_C$	105	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$	$-30 \sim +105$	$^\circ\text{C}$
負荷短絡許容時間	$t_{sb}$	$V_{CC} = \pm 26\text{V}, P_O = 25\text{W}$ $R_L = 8\ \Omega, f = 50\text{Hz}$	2 sec

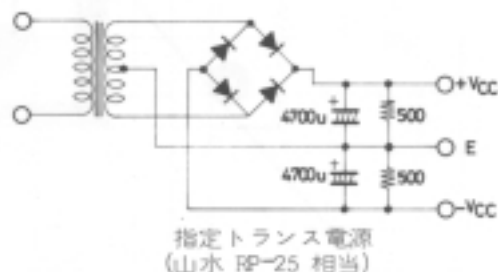
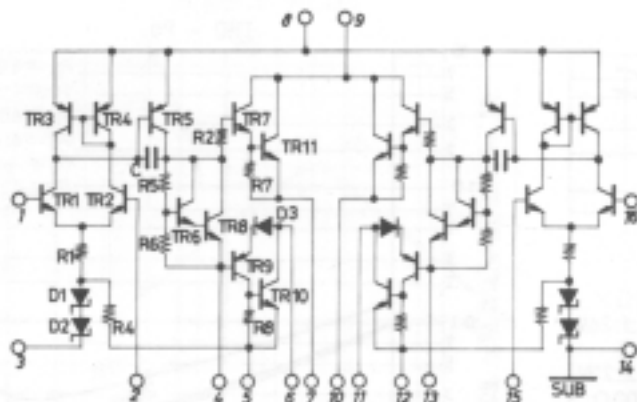
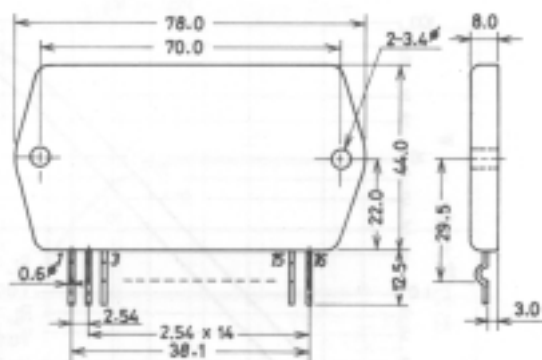
**推奨動作条件 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$** 

			単位
推奨電源電圧	$V_{CC}$	$\pm 26$	V
負荷抵抗	$R_L$	8	$\Omega$

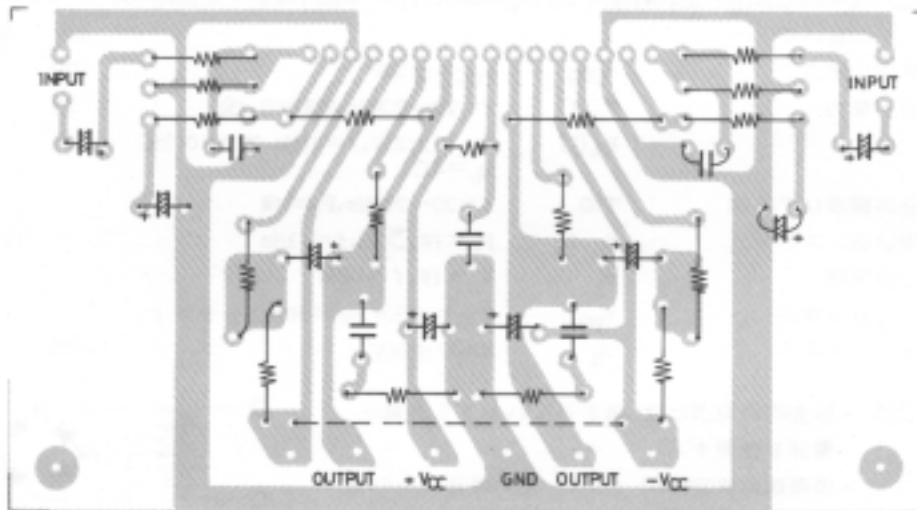
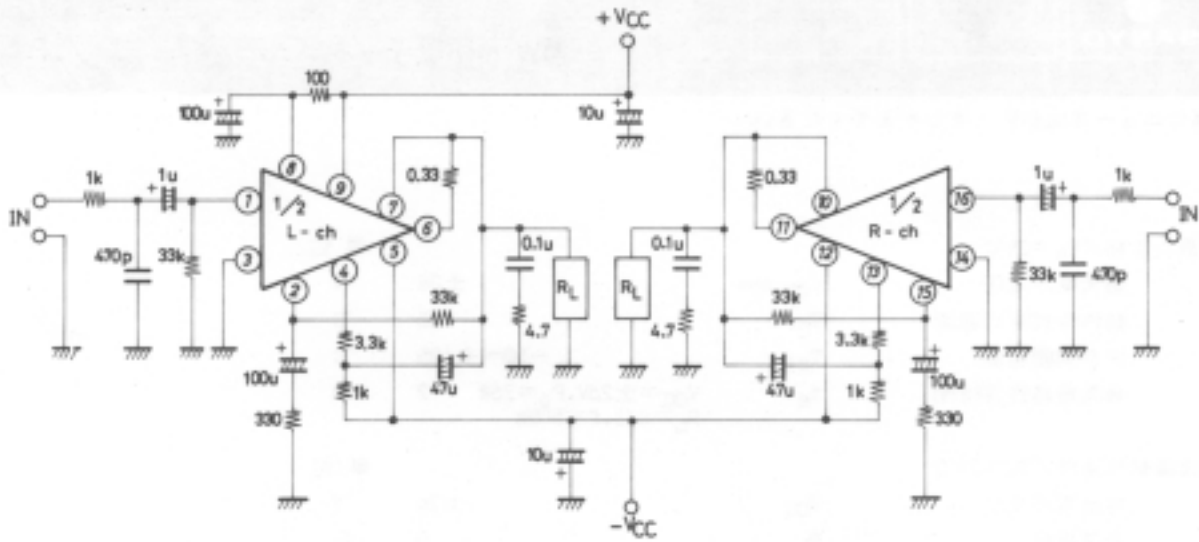
 動作特性 /  $T_a = 25^\circ\text{C}, V_{CC} = \pm 26\text{V}, R_L = 8\ \Omega, R_g = 600\ \Omega, V_G = 40\text{dB}$ , 指定測定回路 (次ページ応用回路例に準ずる)

項目	記号	条件	min	typ	max	単位
無信号電流	$I_{CC0}$	$V_{CC} = \pm 30\text{V}$	20	40	120	mA
出力電力	$P_O(1)$	$f = 20 \sim 20\text{kHz}, \text{THD} = 0.1\%$	25			W
	$P_O(2)$	$V_{CC} = \pm 23\text{V}, f = 1\text{kHz}, \text{THD} = 0.2\%$ $R_L = 4\ \Omega$	30			W
全高調波ひずみ率	THD	$f = 20 \sim 20\text{kHz}, P_O = 1\text{W}$			0.1	%
周波数レスポンス	$f_L, f_H$	$P_O = 1\text{W}, -3\text{dB}, f = 1\text{kHz}$		10~100k		Hz
入力抵抗	$r_i$	$P_O = 1\text{W}, f = 1\text{kHz}$		32k		$\Omega$
出力雑音電圧	$V_{NO}$	$V_{CC} = \pm 30\text{V}, R_g = 10\text{k}\ \Omega$ シヤント			1.2	mVrms
出力中点電圧	$V_N$	$V_{CC} = \pm 30\text{V}$	-70	0	+70	mV

- (注) ・検査時の電源には 指定のないかぎり定電圧電源を使用する。  
 ・負荷短絡許容時間 および 出力雑音電圧の測定は 右図の指定トランス電源を使用する。  
 ・出力雑音電圧は平均値指示型実効値目盛 (VT VM) のピーク値を示す。ただしAC電源はAC1次側ラインのフリッカ性ノイズの影響をなくすためAC安定化電源 (50Hz) を使用する。


**等価回路**

**外形図 (単位: mm)**


■ 応用回路例：30W min 2チャンネル AF パワーアンプ



プリントパターン例 (銅箔面側, 100×55 mm<sup>2</sup>) 100×55 mm<sup>2</sup>

